

Станислав Лилов, Таро Нишигучи, Шигехиро Нишино. ИЗСЛЕДВАНЕ ВЪРХУ УСЛОВИЯТА НА ИЗРАСТВАНЕ ОТ ПАРОВА ФАЗА НА МОНОКРИСТАЛИ ОТ СИЛИЦИЕВ КАРБИД

В настоящата работа са представени резултати от изследването на някои кинетични условия на израстване в процеса на получаване на монокристални слитъци от 6H-SiC. Определен е кинетичния коефициент на кристализация. Получена е експериментална зависимост на преместването на фронта на кристализация от времето в процеса на израстване. Дискутирани са подходящите условия за стабилно израстване на 15R-SiC върху подложки от 6H-SiC и 4H-SiC. За израстването на 15R-SiC върху 6H-SiC и 4H-SiC подложки са необходими температури 2000 °C и 1800 °C, съответно.

Станислав Лилов
Софийски университет “Св. Климент Охридски”
Физически факултет
Катедра “Физика на полупроводниците”
Бул. “Джеймс Баучър” 5
1164 София, България
E-mail: lilovsk@phys.uni-sofia.bg

Постъпила април 2003